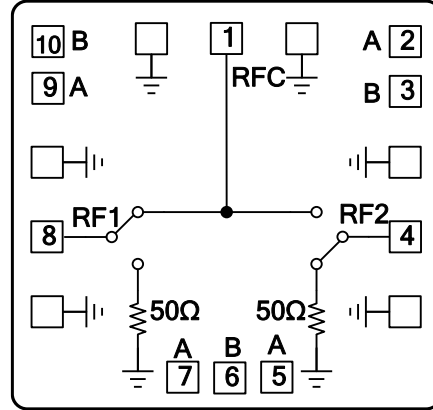




主要特点

- 隔离度: >50 dB @ 20 GHz
- 插入损耗: 1.9 dB @ 20 GHz
- 匹配式设计
- 芯片尺寸: 1.3 × 0.84 × 0.1 mm<sup>3</sup>

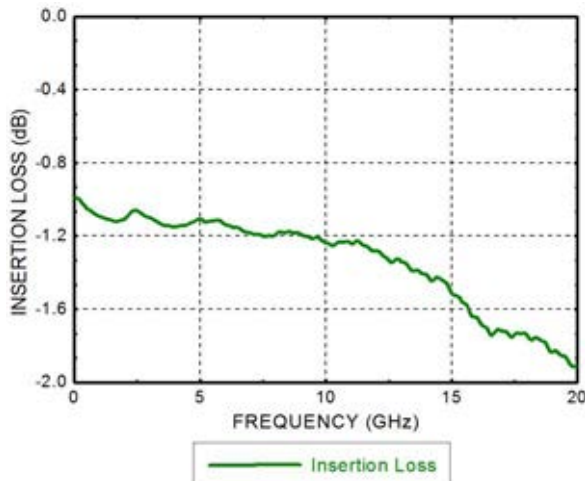
功能框图



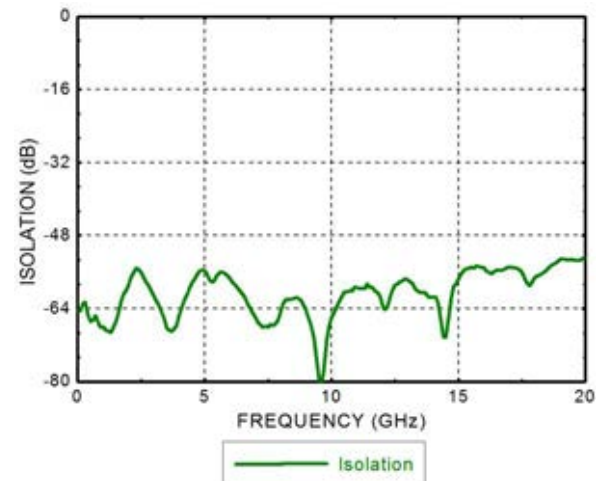
性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CTL} = 0/-5\text{ V}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		DC - 20		GHz
插入损耗		1.9		dB
隔离度		50		dB
回波损耗“打开状态”		20		dB
回波损耗“关闭状态”		22		dB
输入功率 1dB 压缩点 @1-20GHz		25		dBm
开关切换时间		15		ns

插入损耗

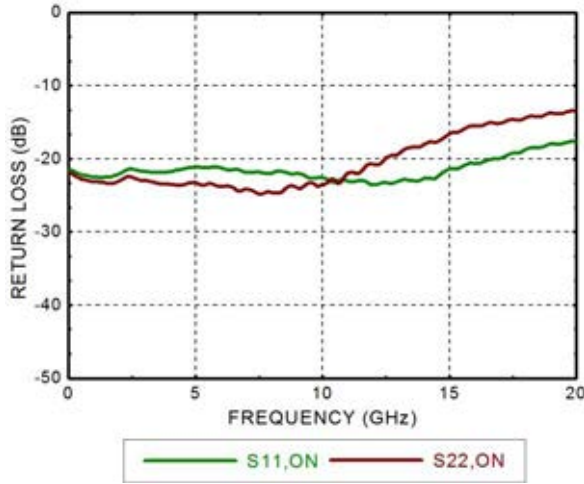


隔离度

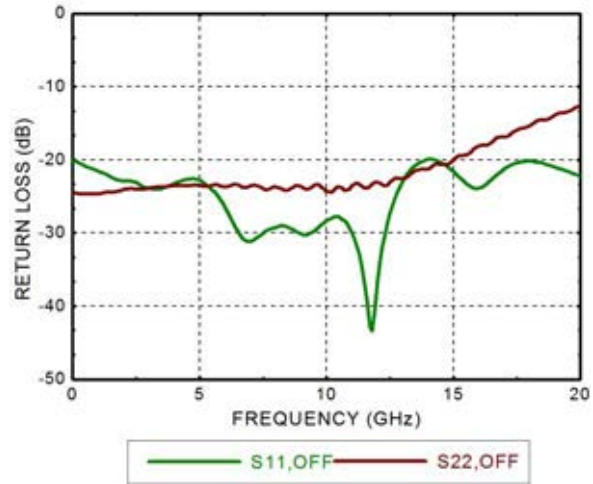




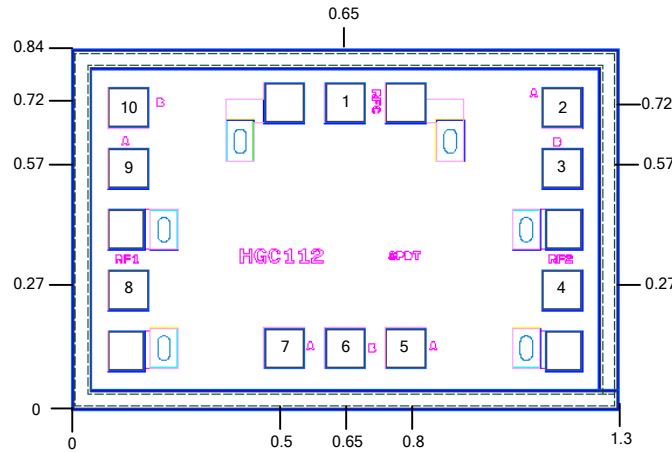
回波损耗, “ON” 状态



回波损耗, “OFF” 状态



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RFC	
8	RF1	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V，那么需要外部加入隔直电容
4	RF2	
2,5,7,9	A	A=0V, B=-5V, 则 RF1 为 “ON” 状态, RF2 为 “OFF” 状态;
3,6,10	B	A=-5V, B=0V, 则 RF1 为 “OFF” 状态, RF2 为 “ON” 状态。
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

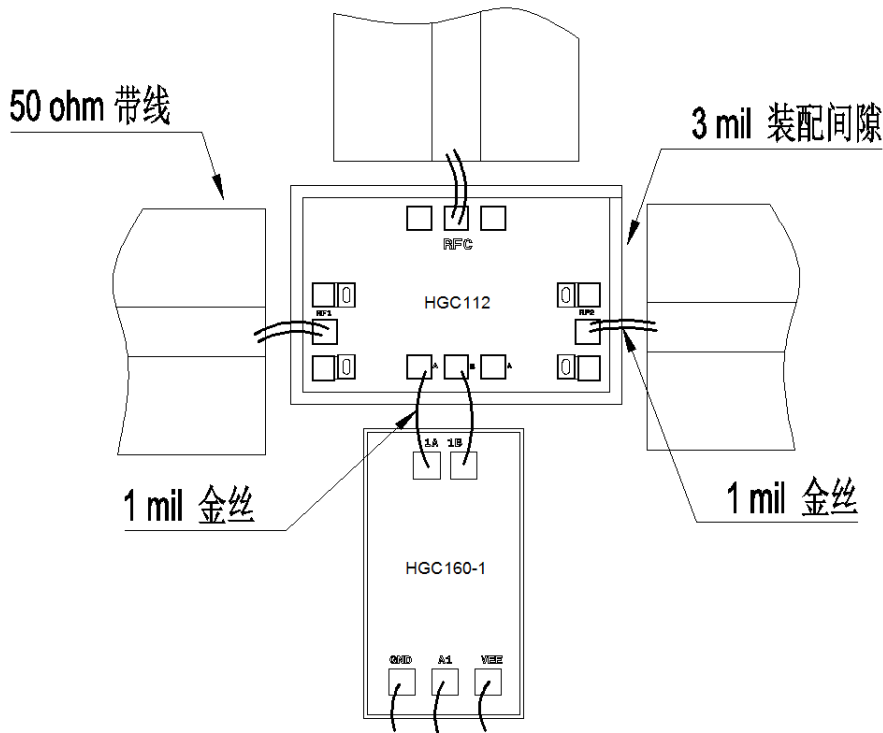


真值表

功能	A	B
RFC-RF1	0	1
RFC-RF2	1	0

“0”电平范围：0~-0.2V，“1”电平范围：-3~-6V。

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为  $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率：+27 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +175°C
3. 工作温度：-55 ~ +85°C